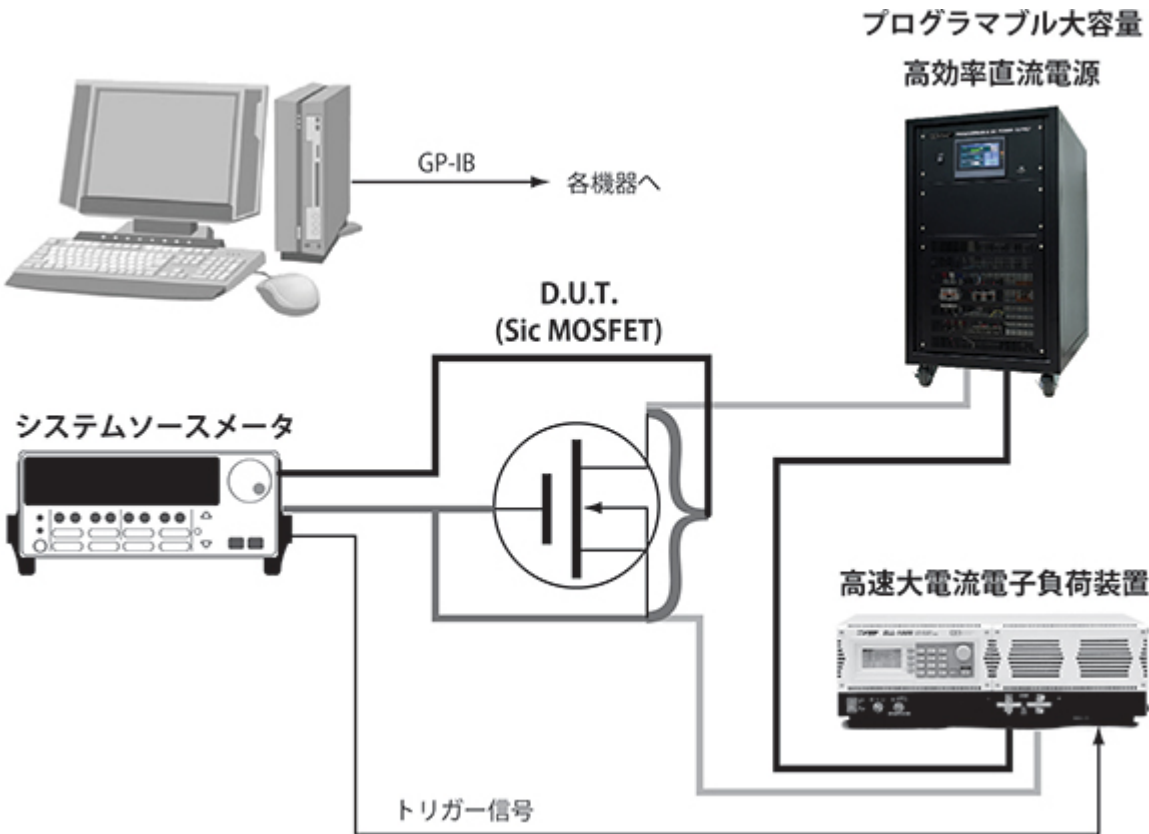


半導体試験装置 MOSFET IGBT ON 試験装置

本装置は、半導体試験装置のON試験装置として、5kW、2025Aの出力能力を有する。また、1つのGateとDrainの端子を有する。また、GateとDrainの端子を有する。

半導体試験装置



半導体

項目	値	単位	備考
測定対象の電圧	2602A	V	デジタルマルチメータ(DMM)で測定した電圧
測定対象の電流	ADG-P	A	30kW, 50kW
測定対象の電力	ELL-1005	W	30V, 405A, 1000W